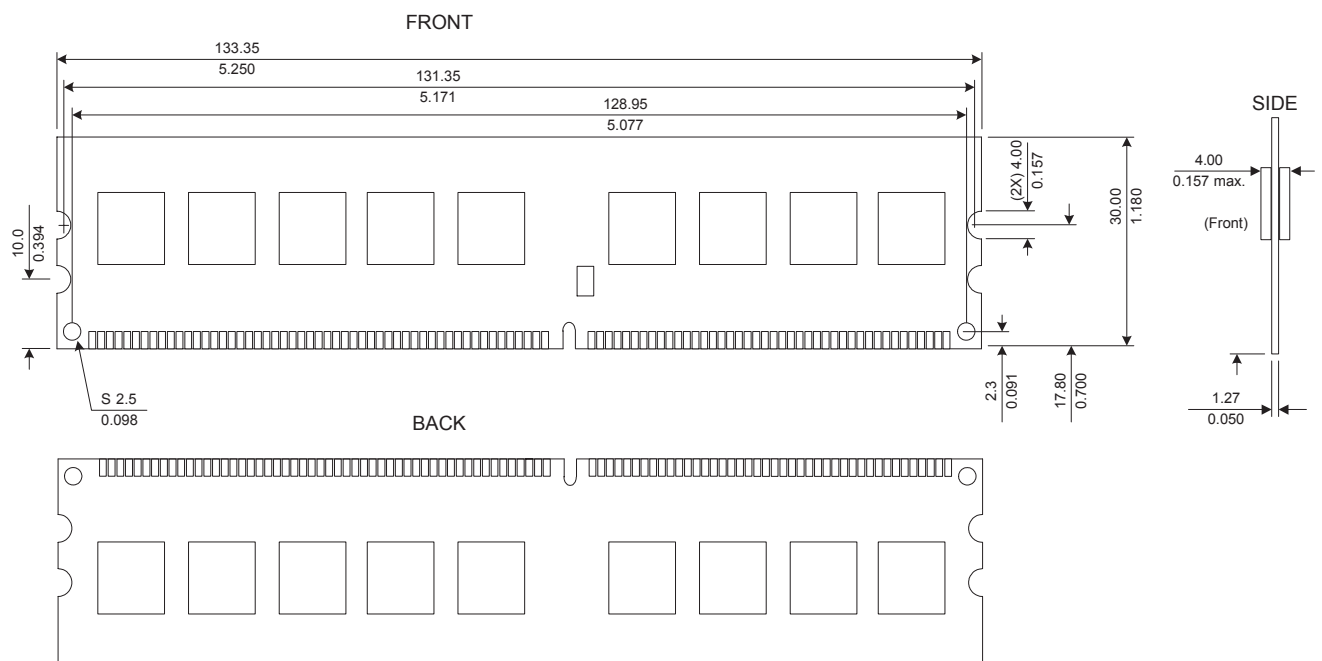


**SMD-2G88E****DESCRIPTION**

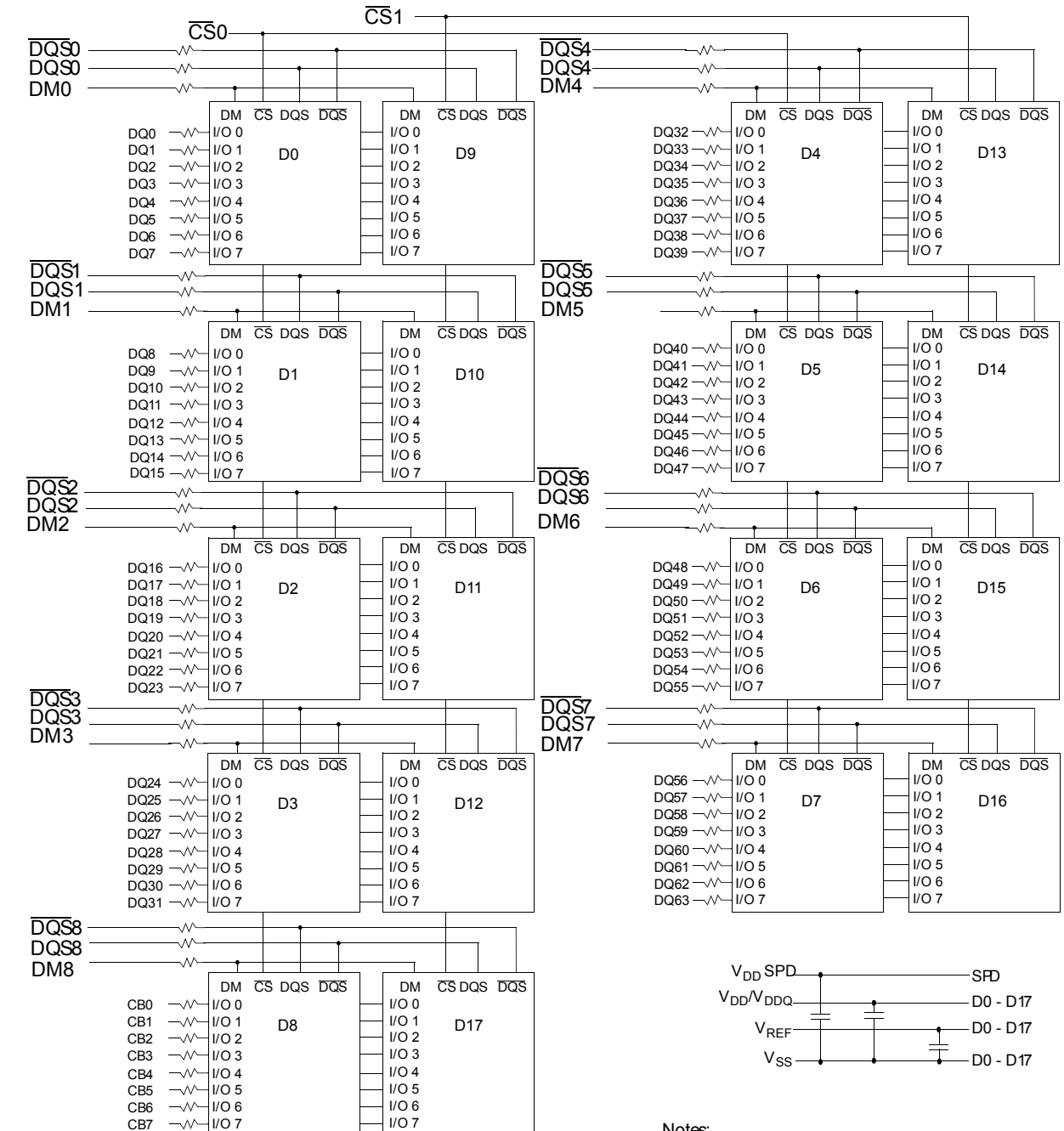
SMD - 2 G 8 8 Eは、1 GビットDDR2・DRAM (128M x 8bit) を18個搭載した256M x 72ビットDDR2・DIMMです。

**FEATURES**

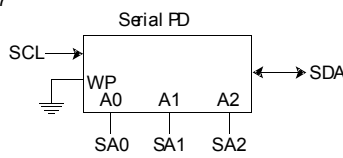
- ・ 240ピン・デュアル・インライン・メモリ・モジュール  
(ピン・ピッチ 1.00mm)
- ・ 基板高 30.0mm
- ・ CL - tRCD - tRP = 5 - 5 - 5 (PC2 - 5300)
- ・ 1.8V ± 0.1V 単一電源
- ・ 8,192リフレッシュ / 64ms
- ・ SSTL\_18コンパチブル
- ・ /CASレイテンシー 3, 4, 5クロックプログラマブル
- ・ 2ランク構成
- ・ アンバッファードタイプ、ECC
- ・ OCD (オフチップドライバー インピーダンス アジャストメント)
- ・ ODT (オンダイ ターミネーション)
- ・ 接続端子：電解金メッキ (t 0.76 μm)
- ・ Pbフリー、RoHS対応品

**Outline Dawing**

**Functional Block Diagram**



- BA0 - BA2 → BA0-BA2: SDRAMs D0 - D17
- A0 - A13 → A0-A13: SDRAMs D0 - D17
- CKE0 → CKE: SDRAMs D0 - D8
- CKE1 → CKE: SDRAMs D9 - D17
- RAS → RAS: SDRAMs D0 - D17
- CAS → CAS: SDRAMs D0 - D17
- WE → WE: SDRAMs D0 - D17
- ODT0 → ODT: SDRAMs D0 - D8
- ODT1 → ODT: SDRAMs D9 - D17



- Notes:
1. DQ-to-I/O wiring is shown as recommended but may be changed.
  2. DQ/DQS/DQS/ODT/DM/CKE/CS relationships must be maintained as shown.
  3. DQ, CB, DQS, DM/DQS/DQS resistors: Refer to associate topology diagram
  4. BAx, Ax, RAS, CAS, WE resistors: Refer to associate topology diagram.